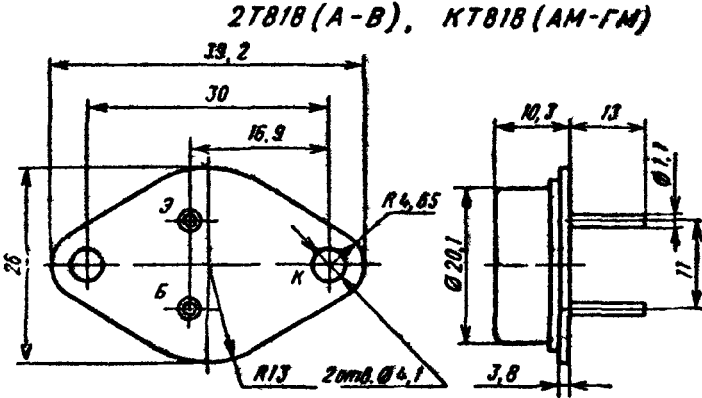
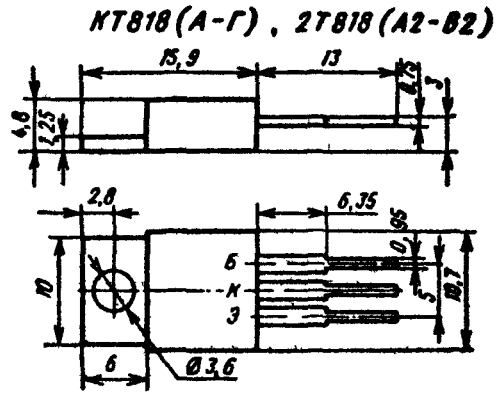


**2Т818 (А, Б, В), 2Т818 (А2, Б2, В2),
КТ818 (АМ, БМ, ВМ, ГМ), КТ818 (А, Б, В, Г)**

Транзисторы кремниевые меза-эпифаксиально-планарные структуры р-п-р переключаемые. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Корпус металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами (2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В, КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ) и пластмассовый с жесткими выводами (2Т818А2, 2Т818Б2, 2Т818В2, КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г).

Масса транзистора в металлическом корпусе не более 20 г, в пластмассовом корпусе не более 2,5 г.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ}=5$ В, $I_K=5$ А, не менее:

$T = +25^\circ\text{C}$ и $T = T_{к.макс}$:

2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В, 2Т818А2, 2Т818Б2, 2Т818В2	20
КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818АМ, КТ818ВМ	15
КТ818Б, КТ818БМ	20
КТ818Г, КТ818ГМ	12

$T = T_{мин}$:

2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В, 2Т818А2, 2Т818Б2, 2Т818В2	9
КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818АМ, КТ818ВМ	10
КТ818Б, КТ818БМ	15
КТ818Г, КТ818ГМ	7

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ}=5$ В, $I_K=20$ А, для 2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В

4*...7*...15*

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ}=5$ В, $I_B=0,5$ А

3*...4,5* 7* МГц

Граничное напряжение при $I_B=0,1$ А:

2Т818А, 2Т818А2, КТ818Г, КТ818ГМ	80 100* 150* В
2Т818Б, 2Т818Б2, КТ818В, КТ818ВМ	60 80* 100* В
2Т818В, 2Т818В2, КТ818Б, КТ818БМ	40...60* 80* В
КТ818А, КТ818АМ, не менее	20 В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер:

при $I_K=5$ А, $I_B=0,5$ А, не более:

2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В, 2Т818А2, 2Т818Б2, 2Т818В2	1 В
КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г, КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ	2 В

при $I_K=20$ А, $I_B=5$ А:

2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В	0,7...1,5...4 В
2Т818А2, 2Т818Б2, 2Т818В2, не более	5 В
КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г, КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ	0,7...1,5...5 В

Напряжение насыщения база — эмиттер:

при $I_K=5$ А, $I_B=0,5$ А, не более:

2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В, 2Т818А2, 2Т818Б2, 2Т818В2	1,5 В
КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г, КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ	3 В

при $I_K=20$ А, $I_B=5$ А для 2Т818А, 2Т818Б,

2Т818В, 2Т818А2, 2Т818Б2, 2Т818В2	1,6...2,3...5 В
-----------------------------------	-----------------

Пробивное напряжение коллектор — эмиттер при $I_K = 1$ мА, $R_{02} \leq 100$ Ом:	
2Т818А, 2Т818А2	100...140*...180° В
2Т818Б, 2Т818Б2	80...105*...120° В
2Т818В, 2Т818В2	60...80*...110° В
Пробивное напряжение коллектор — база:	
при $T = -60 \dots +25^\circ\text{C}$, $T_K = 1$ мА:	
2Т818А, 2Т818А2	100...130*...200° В
2Т818Б, 2Т818Б2	80...100*...120° В
2Т818В, 2Т818В2	60...80*...100° В
при $T = T_{н. макс.}$, $I_K = 5$ мА 2Т818А, не менее:	
2Т818А2	100 В
2Т818Б, 2Т818Б2	80 В
2Т818В, 2Т818В2	60 В
Пробивное напряжение база — эмиттер при $I_B = 5$ мА	5...3*...30° В
Обратный ток коллектора при $U_{KB} = 40$ В, для КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г, КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ, не более:	
$T = -40 \dots +25^\circ\text{C}$	1 мА
$T = +100^\circ\text{C}$	10 мА
Время выключения при $U_{KB} = 5$ В, $I_K = 0,5$ А, не более	2,5* мкс
Емкость коллекторного перехода при $U_{KB} = 5$ В, $f = 1$ МГц	400*...800.. 1000 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{EB} = 0,5$ В, $f = 1$ МГц, не более	2000* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база:	
2Т818А, 2Т818А2	100 В
2Т818Б, 2Т818Б2	80 В
2Т818В, 2Т818В2	60 В
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{02} \leq 100$ Ом:	
$T = -60 \dots +80^\circ\text{C}$ для 2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В,	
$T = -60 \dots +40^\circ\text{C}$:	
2Т818А2, 2Т818Б2, 2Т818В2:	
2Т818А, 2Т818А2	100 В
2Т818Б, 2Т818Б2	80 В
2Т818В, 2Т818В2	60 В
$T = -40 \dots +25^\circ\text{C}$:	
КТ818А, КТ818АМ	40 В
КТ818Б, КТ818БМ	50 В
КТ818В, КТ818ВМ	70 В
КТ818Г, КТ818ГМ	90 В
Постоянное напряжение база — эмиттер	5 В
Постоянный ток коллектора:	
КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г	10 А
2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В, 2Т818А2, 2Т818Б2, 2Т818В2, КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ	15 А
Импульсный ток коллектора при $t_n \leq 10$ мс, $Q > 100$ ($Q > 2$ для 2Т818А2, 2Т818Б2, 2Т818В2):	
КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г	15 А
2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В, 2Т818А2, 2Т818Б2, 2Т818В2, КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ	20 А

Постоянный ток базы	3 А
Импульсный ток базы	5 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора¹ при $T_{\kappa} = T_{\kappa \text{ мин}} = +25^{\circ}\text{C}$:

с теплоотводом

2Т818А2, 2Т818Б2, 2Т818В2	40 Вт
КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г	60 Вт
2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В, КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ	100 Вт

без теплоотвода.

2Т818А2, 2Т818Б2, 2Т818В2	1 Вт
КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г	1,5 Вт
КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ	2 Вт
2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В	3 Вт

Температура р-п перехода.

2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В, 2Т818А2, 2Т818Б2, 2Т818В2	+150 °С
КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г, КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ	+125 °С

Температура окружающей среды:

2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В	-60 °С... $T_{\kappa} = +125^{\circ}\text{C}$
2Т818А2, 2Т818Б2, 2Т818В2	-60 °С... $T_{\kappa} = +100^{\circ}\text{C}$
КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г, КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ	-40 °С... $T_{\kappa} = +100^{\circ}\text{C}$

¹ При повышении температуры окружающей среды (корпуса) свыше +25°С постоянная рассеиваемая мощность коллектора для 2Т818А, 2Т818Б, 2Т818В рассчитывается по формулам

$$P_{\kappa, \text{ макс.}} \text{ Вт} = (150 - T_{\kappa}) / 1,25 \text{ (с теплоотводом);}$$

$$P_{\kappa, \text{ макс.}} \text{ Вт} = (150 - T_{\kappa}) / 41,6 \text{ (без теплоотвода);}$$

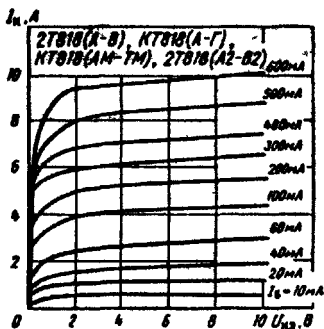
для 2Т818А2, 2Т818Б2, 2Т818В2 уменьшается линейно на 0,32 Вт/°С с теплоотводом и на 0,015 Вт/°С без теплоотвода; для КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г уменьшается на 0,6 Вт/°С с теплоотводом и на 0,015 Вт/°С без теплоотвода; для КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ уменьшается на 1 Вт/°С с теплоотводом и на 0,02 Вт/°С без теплоотвода.

При монтаже транзисторов 2Т818А2, 2Т818Б2, 2Т818В2, КТ818А, КТ818Б, КТ818В, КТ818Г допускается одноразовый изгиб выводов не ближе 2,5 мм от корпуса под углом 90° радиусом не менее 0,8 мм. При этом должны приниматься меры, исключающие возможность передачи усилий на корпус. Изгиб в плоскости выводов не допускается.

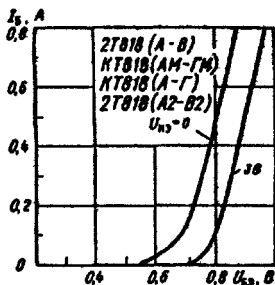
Пайка выводов транзисторов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса. При пайке жала паяльника должно быть заземлено. Допускаются пайка без теплоотвода и групповой метод пайки. Температура припоя +260 °С, время пайки не более 3 с, время лужения выводов не более 2 с.

При включении транзистора в цепь, находящуюся под напряжением, базовый вывод должен присоединяться первым и отключаться последним.

Допустимое значение статического потенциала 1000 В

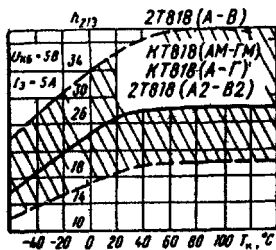
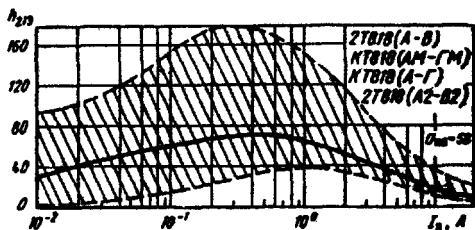


Выходные характеристики

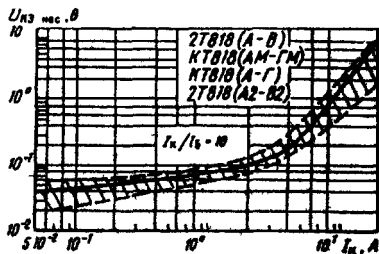


Входные характеристики

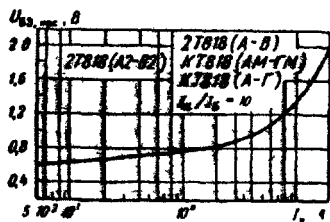
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



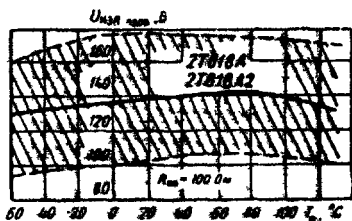
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от температуры корпуса



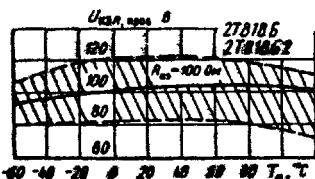
Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения коллектор — эмиттер от тока коллектора



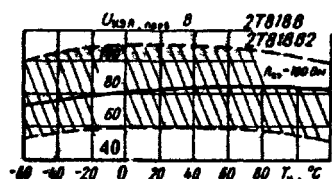
Зависимость напряжения насыщения база — эмиттер от тока коллектора



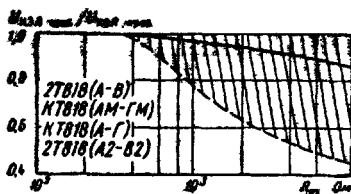
Зона возможных положений зависимости пробивного напряжения коллектор — эмиттер от температуры корпуса



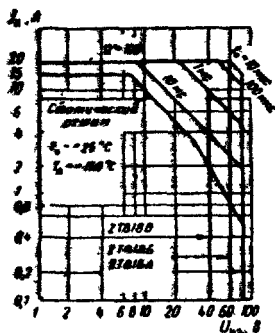
Зона возможных положений зависимости пробивного напряжения коллектор — эмиттер от температуры корпуса



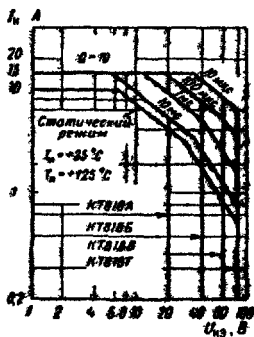
Зона возможных положений зависимости пробивного напряжения от температуры корпуса



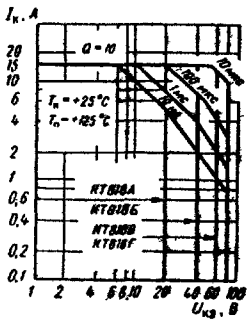
Зона возможных положений зависимости пробивного напряжения от сопротивления база — эмиттер



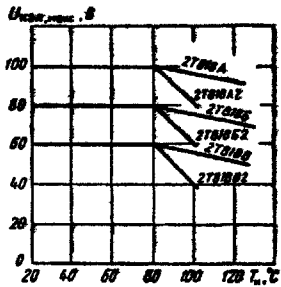
Области максимальных режимов



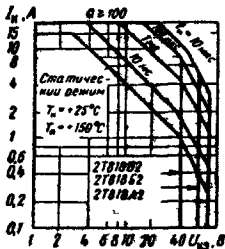
Области максимальных режимов



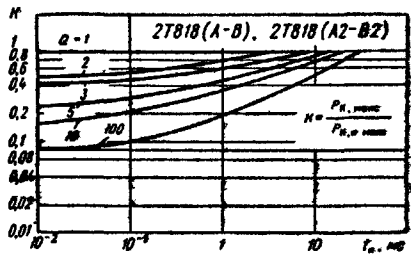
Области максимальных режимов



Зависимости максимально допустимого постоянного напряжения коллектор — эмиттер от температуры корпуса



Области максимальных режимов



Зависимости коэффициента K от длительности импульса